

MES 2011 プログラム

9月8日(木)

	A会場	B会場	C会場
10:20	【IA1】ナノマテリアル <ol style="list-style-type: none"> 樹脂/金属間におけるナノ構造界面の構築と樹脂上への金属バターン形成 ○福本ユリナ, 谷山智紀, 鶴岡孝章, 赤松謙祐, 繩舟秀美(甲南大学) 高熱伝導性Ag/カーボンナノチューブ複合材料の開発 ○井上雅博¹, 林大和², 山田雄大², 滝澤博胤² (¹大阪大学, ²東北大) Agフレークを用いた低温接合用ダイボンディング材料 ○坂元創一, 菅沼克昭(大阪大学) 耐マイグレーション性配線材料としての銀-銅複合ナノ粒子 ○柏木行康¹, 山本真理¹, 斎藤大志¹, 大野敏信¹, 垣内宏之², 吉田幸雄², 中許昌美¹ (¹大阪市立工業研究所, ²大研化学製造販売) 	【IB1】回路基板I <ol style="list-style-type: none"> バラジウムナノ粒子/ポリマーハイブリッド層を利用したプラスチックフィルム表面上の銅配線形成 ○玉井聰行, 渡辺充, 渡瀬星児, 松川公洋(大阪市立工業研究所) エチレンジアミン錯体浴からのITO透明導電膜上への直接銅電析 ○有村英俊^{1,3}, 鶴岡孝章², 赤松謙祐², 繩舟秀美², 川端愛³ (¹甲南大学大学院, ²甲南大学, ³石原薬品) めっきプロセスに対する導体ベーストのガラス成分が及ぼす影響 ○長尾由起, 村橋浩一郎, 津野勇輝, 田邊清博(奥野製薬工業) 第4高調波YAGレーザを用いた小径ビア加工技術の開発 ○飯野正和(京セラ SLCテクノロジー) 	【IC1】検査技術 <ol style="list-style-type: none"> TFT配線における磁気結合方式に基づく短絡欠陥位置特定手法 ○羽森寛, 坂和正敏, 片桐英樹, 松井猛(広島大学大学院) リチウムイオン電池向けR2Rフィルムのバリ検査技術開発 ○松村淳一, 常吉豪, 大美英一, 谷川央樹(東レエンジニアリング) 生産現場における全数自動検査のための高速CT検査技術 ○杉田信治, 益田真之, 村上清, 加藤訓之(オムロン) 吸収型マイクロCTによるCO₂レーザ融着光ファイバの構造評価 ○小池真司, 浅川修一郎, 小林潤也, 上杉健太朗, 竹内晃久, 星野真人, 鈴木芳生, 渡辺義夫 (¹日本電信電話, ²高輝度光科学研究所センター)
11:40		休憩	
12:40			
12:40	【IA2】先端材料I <ol style="list-style-type: none"> 無色透明な耐熱樹脂の合成と性質—ノルボルナン構造の脂環式ポリイミド— ○松本利彦(東京工芸大学) In-situ重合により調製した透明エボキシ/ジコニアハイブリッド体の光学的および熱的性質 ○越智光一, 新居大輔, 原田美由紀(関西大学) 光インターコネクト用硬化性液状樹脂 ○大森健太郎, 佐藤哲夫, 日高基彦, 繩田秀行(日産化学工業) 環境対応材料高分子アクチュエータの開発 ○東野雄樹, ○中井隆晶, 植原勇介, 片岡拓也, 福本貴宏, 井上雅隆, 犬塚雄介, 大西克己, 田實佳郎(関西大学学院) ハイブリッド高透率材料 ○松村和行, 松葉聰, 新関彰一, 朝日昇, 野中敏央(東レ) 	【IB2】回路基板II <ol style="list-style-type: none"> プリント配線近傍に生じる静電容量を用いた欠陥検出システムに関する研究 ○野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊, 富田英雄(東京電機大学) ペルオキソ二硫酸アンモニウム溶液による銅のエッチング速度に結晶構造が及ぼす影響 ○久保田賢治^{1,2}, 新山貴士¹, 松本克才³, 吉原佐知雄¹ (¹宇都宮大学大学院, ²三菱マテリアル, ³八戸高等専門学校) 急速液置換による銅めっき用有機系添加剤の吸脱着挙動解析 ○宮本豊, 服部直, 岡本尚樹, 齋藤丈靖, 近藤和夫(大阪府立大学大学院) ダイレクトメタラリゼーション法により作製した透明ボリミドフィルム上の銅めっき皮膜の密着強度 ○池田慎吾¹, 小林靖之¹, 藤原裕¹, 赤松謙祐², 繩舟秀美² (¹大阪市立工業研究所, ²甲南大学) ITOのハイブリッド成膜の開発 ○稻葉和久, 田中英樹, 安部真司, 土門孝彰(TDK) 	【IC2】評価シミュレーションI <ol style="list-style-type: none"> モジュール製品の反りシミュレーション技術の開発 ○橋本健, 川端孝弘, 乙脇康夫, 谷本靖忠(村田製作所) 光トランシーバにおける熱解析シミュレーションと電磁界シミュレーションを活用した解析手法の提案 ○石井邦幸, 大森寛康, 倉島宏実(住友電気工業) nMOSFETにおける1軸応力の影響評価 ○小金丸正明¹, 多田直弘², 池田徹², 宮崎則幸², 友景肇³ (¹福岡県工業技術センター, ²京都大学大学院, ³福岡大学) Pre-Appliedアンダーフィルプロセスに対する構造解析シミュレーション ○岡本圭司, 烏山和重, 松本圭司, 折井靖光(日本アイ・ビー・エム)
14:20			

	A会場	【セッション会場】
14:30	MES 2010 表彰式 ・ベストペーパー賞 ・研究奨励賞	A会場: ホール1
14:45	招待講演	B会場: ホール2
14:50	1. 低温接合からみた環境対応実装技術 須賀唯知(東京大学大学院 教授) 2. 半導体的一大転換期が来た~省エネがすべてのキーワード~ 泉谷渉(産業タイムズ社 代表取締役社長)	C会場: 第4, 5, 6会議室
16:50		

17:00	交流会 会場: レストラン「紫紺」(100周年記念会館3階) *参加費は別途必要です。
19:00	

	A会場	B会場	C会場
9:10	[2A1] 先端材料 II <ol style="list-style-type: none"> 構造制御による液晶性エポキシ/BN充填系の高熱伝導化 ○原田美由紀, 濱浦奈々, 安藤純一朗, 越智光一(関西大学) 可溶性LCPを用いた高放熱基板の開発 ○岡本敏¹, 根津秀明¹, 宮越亮¹, 近藤剛司¹, 水野克美², 夏目豊², 小林康良²(住友化学, ²日本発条) 種々のフィラーを含有する熱伝導性接着剤の熱輸送特性における伝導電子の寄与 ○井上雅博¹, 牟田浩明², 山中伸介², リュウヨハン³(¹大阪大学産業科学研究所, ²大阪大学大学院, ³チャルマース工科大学) 導電接着剤における電極間導電経路の3次元可視化 ○荒尾修, 新堀亮, 杉浦昭夫(デンソー) 高分子光弹性センサ ○高井恭平, 黒田慎太郎¹, 木下俊輔¹, 中嶋康人¹, 上村裕輝¹, 森田哲也¹, 高和宏行², 村木可苗², 守本雄², 篠地光雄², 田實佳郎¹(関西大学大学院, ²ユニオプト) 	[2B1] めっき技術 <ol style="list-style-type: none"> ジアリルアミン系レベラーを用いた銅穴埋めめっき ○阿南善裕¹, 竹内実^{1,2}, 岡本尚樹¹, 斎藤丈靖¹, 文屋勝², 近藤和夫¹(¹大阪府立大学, ²日東紡績) 無電解Ni/Pd/Auめっき皮膜のはんだ実装信頼性とNiめっき皮膜中に共析した微量添加剤(Pb, S)濃度の関係 ○土田徹勇起¹, 大久保利一¹, 狩野貴宏², 荘司郁夫²(¹凸版印刷総合研究所, ²群馬大学大学院) 電解めっきによるSn-Cu系合金の形成と膜特性評価 ○西村清賢¹, 井上史大¹, 清水智弘¹, 照井通文², 新宮原正三¹(¹関西大学, ²情報通信研究機構) 耐硫化性および耐熱性に優れたLED照明用積層構造 ○青木智美¹, 片山順一¹, 銚舟秀美²(¹奥野製薬工業, ²甲南大学) 	[2C1] 通信・伝送 <ol style="list-style-type: none"> メタマテリアル技術を応用したEBG構造の検討—ビアレスEBG構造による電源系ノイズ抑制— ○上谷純, 城田健一, 八木貴弘, 中澤哲夫(沖縄プリントドーキット) 差動伝送線路を対象とした平衡度不整合モデルによるコモンモード電流予測法の検証 ○松嶋徹¹, 渡辺哲史², 豊田啓孝³, 古賀隆治³, 和田修己¹(¹京都大学大学院, ²岡山県工業技術センター, ³岡山大学大学院) 微細Auバンブを用いた接続構造体の信号伝送特性評価 ○安陽太郎^{1,2}, 菊地克弥², 加藤史樹², 根本俊介², 仲川博², 越地耕二¹, 青柳昌宏^{1,2}(¹東京理科大学, ²産業技術総合研究所) 発表中止
10:50			
11:00	[2A2] 基板材料 <ol style="list-style-type: none"> ハロゲンフリー難燃性カバーレイ用エポキシ/リン含有フェノキシ系接着剤の特性(依頼講演) ○横山直樹, 雨澤修, 会田勝之(新日鐵化学) ボリイミドフィルムへの無電解めっきと微細配線の形成 ○横沢伊裕, 番場啓太, 三浦徹, 幸田政文(宇部興産) 超低CTE材料を用いた機能性低CTE複合基板 ○土屋俊之¹, 岡本淳¹, 前田郷司¹, 塚田裕²(¹東洋紡績, ²i-PACKS) 狭ピッチ回路の無電解めっき技術 ○金子美晴, 小山稔, 富山浩二(レイテック) 	[2B2] 封止材 <ol style="list-style-type: none"> SIP用高信頼性MUF(Mold-Underfill)材と封止プロセス技術 ○石川有紀, 永井孝一良, 奥野敦史(サンユレック) アンダーフィル樹脂のフィレット形成とチップ保護性の検討 ○澤田祐子¹, 阿部剛², 斎藤隆幸³, 徳永宗治³(¹三菱電機, ²メルコセミコンダクタエンジニアリング, ³ルネサスエレクトロニクス) 次世代半導体パッケージ用材料システムの検討 ○竹越正明, 鈴木直也, 尾瀬昌久, 池内孝敏(日立化成工業) 鉛フリーに対応したエリアアレイ型フリップチップのファインピッチ化による信頼性への影響 ○大野英司(日本アイ・ビー・エム) 	[2C2] パワーエレクトロニクス <ol style="list-style-type: none"> 電磁界共鳴を用いたワイヤレス電力伝送の検討 ○今野宗一郎, 山本隆彦, 越地耕二(東京理科大学) SPICEシミュレータによる単相フルブリッジインバータ回路のノイズ解析 ○桐畠美耶¹, 高橋成正², 柳田進¹(¹ライズコボレーション, ²日本アイ・ビー・エム) SiCデバイスの特長を活かす高パワー密度、高信頼性を実現するパワーモジュール構造 ○梨子田典弘, 堀尾真史, 飯塚祐二, 日向裕一郎, 池田良成, 高橋良和(富士電機) 高熱伝導性銀接着剤 ○塙直人(ハリマ化成)
12:20			
	休憩		
13:20	[2A3] JEITA電子部品技術ロードマップ2011 実装技術ロードマップ2011概要報告 (13:20~14:00) <ol style="list-style-type: none"> 電子部品から見た注目電子機器市場の動向 石井浩一(TDK-EPC) (14:00~14:30) <ol style="list-style-type: none"> 電子部品技術ロードマップから見た主要電子部品の動向(LCR) 梶田栄(村田製作所) (14:30~15:00) <ol style="list-style-type: none"> その他電子部品技術の動向(コネクタ/入出力デバイス) 松尾秀治(アルプス電気) 	[2B3] 評価シミュレーションII <ol style="list-style-type: none"> フリップチップはんだ接続部のエレクトロマイグレーション解析と放射光X線CT観察 ○谷江尚史¹, 藤原伸一¹, 千綿伸彦², 藤吉優², 新谷寛¹, 春別府佑¹(¹日立製作所, ²日立金属) プリント配線板のIVH(Interstitial Via Hole)における熱疲労寿命のばらつきに関する解析的検討 ○竹中国浩^{1,2}, 于強²(¹安川電機, ²横浜国立大学) 鉛フリーはんだ材の結晶異方性に関する検討 ○瀬戸山大吾, 池畠秀哲, 長廻尚之, 鈴木智博(豊田中央研究所) PBGAの熱特性測定と過渡シミュレーションモデルによる温度プロファイル定義 ○山田靖治(日本アイ・ビー・エム) 小型半導体パッケージの微小剥離による熱抵抗変化 ○崔雲, 江村直之, 友景肇(福岡大学) 	[2C3] EMI <ol style="list-style-type: none"> 三次元集積システムへ向けたキャバシタ内蔵インターポーラによる電源ノイズ抑制効果 ○菊地克弥¹, 秋山豊², 島倉啓³, 竹村浩一³, 五明利雄³, 大久保利一³, 小山鉄也³, 村上朝夫³, 青柳昌宏¹, 大塚寛治²(¹産業技術総合研究所, ²明星大学, ³ASET) チップの電源等価回路を用いたEMI解析手法の検討 ○海谷清彦¹, 金子俊之¹, 富島敦史², 須藤俊夫³(¹トッパンNEC サーキットソリューションズ, ²東芝, ³芝浦工業大学) 電源供給系のトランシスナー・インピーダンス低減によるプリント基板からの放射ノイズ抑制手法 ○本木浩之, 中西秀行, 田中顕裕(アイカ工業) 真空印刷工法による高周波部品のシールド工法 ○小国隆志(東レエンジニアリング)
15:00	(15:00~15:20 休憩)		
15:10	 (15:20~16:10) <ol style="list-style-type: none"> 実装技術ロードマップから見た実装技術の動向 本多進(NPO法人 サーキットネットワーク) (16:10~16:50) <ol style="list-style-type: none"> 実装技術ロードマップ(トピックス):環境対応実装技術の動向 青木正光(NPO法人 日本環境技術推進機構) 	[2B4] 先端パッケージ <ol style="list-style-type: none"> 薄化シリコンチップの接合法 ○末岡邦昭, 堀部晃宏, 佐久間克幸, 阿部由之, 宮崎忠一, 山田文明, 折井靖光(超先端電子技術開発機構) 無電解パリアメタルを用いたオールウェットCu-TSVの形成と評価 ○有馬良平, 井上史大, 三宅浩志, 清水智弘, 新宮原正三(関西大学) 部品内蔵配線板を応用した3次元実装モジュールの開発 ○勝原康彦, 荒木登, 笹岡賢司, 豊吉令欧(大日本印刷) TMV-POP実装に用いる転写材料の開発 ○宗像宏典, 圓尾弘樹, 境忠彦(パナソニックファクトリーソリューションズ) 表面活性化接合および微細嵌合構造を用いたポリマーMEMSの実装に関する研究 ○天谷諭, ダオベトズン, 杉山進(立命館大学) 	[2C4] はんだ接合 <ol style="list-style-type: none"> 界面反応層構造に及ぼすNi添加の影響 ○山内啓(北海道大学大学院) Sn-Bi系はんだを用いたBGA接合部の耐衝撃性向上に及ぼすSb添加の効果 ○岡本圭史郎¹, 今泉延弘¹, 赤松俊也¹, 作山誠樹¹, 上西啓介¹(¹富士通研究所, ²大阪大学大学院) Au-Ge半田/Ni(P)接合界面の微細構造 ○郎豊群, 山口浩, 佐藤弘(産業技術総合研究所) エレクトロマイグレーション現象における実効原子価算出方法の検討 ○藤吉優¹, 千綿伸彦², Jung Kyu Hau², Daechul Choi², King-Ning Tu²(¹日立金属, ²UCLA) 融点変化型低温接合材料の実装検討 ○北嶋雅之¹, 八木友久², 伊達仁昭², 山上高豊¹, 久保田崇¹, 吉良秀彦¹(¹富士通アドバンストテクノロジ, ²富士通クオリティ・ラボ)
16:50			